

Silicon Diode

1N4151

75V / 200mA

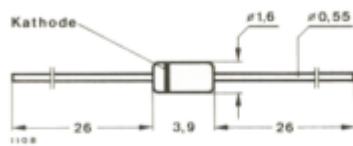
DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

1N 4151**Silizium-Epitaxial-Planar-Diode****Anwendungen:** Extrem schnelle Schalter**Besondere Merkmale:**

- ● Auch als „Gütebestätigtes Bauelement“ nach: VG 95 288 oder GW H 0000 als HIREL-Bauelement: DL 106 lieferbar

Abmessungen in mm

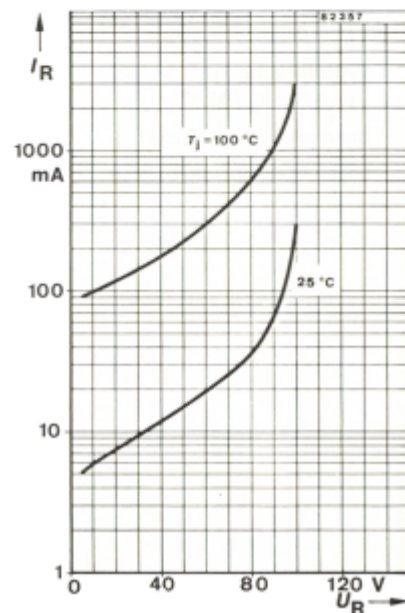
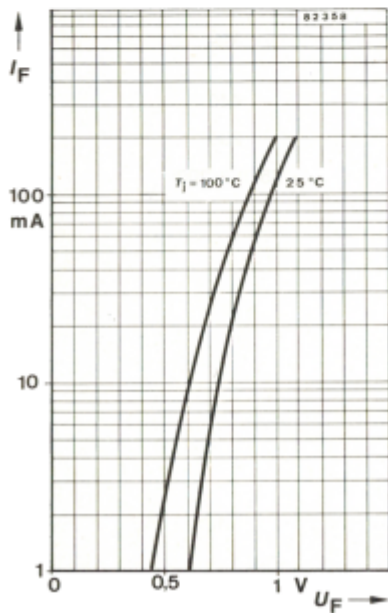
Normgehäuse
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext oder JEDEC Farbcodierung**Absolute Grenzwerte**

Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	75	V
Sperrspannung	U_R	50	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p < 1 \mu s$	I_{FSM}	2000	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	450	mA
Durchlaßstrom	I_F	200	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert $U_R = 0$	I_{FAV}	150	mA
Verlustleistung $l = 4 \text{ mm}, T_L = 45 \text{ }^\circ\text{C}$	P_V	440	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	200	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65....+ 200	$^\circ\text{C}$

1N4151

Wärmewiderstand		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$				350	K/W
Kenngrößen					
$T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 50 \text{ mA}$			0,88	1	V
Sperrstrom $U_R = 50 \text{ V}$				50	nA
$U_R = 50 \text{ V}, T_J = 150 \text{ }^\circ\text{C}$				50	μA
Durchbruchspannung $I_R = 5 \text{ } \mu\text{A}$			75		V
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 1 \text{ MHz}, U_{HF} = 50 \text{ mV}$			1,7	2	pF
Rückwärtserholzeit $I_F = I_R = 10 \text{ mA}, i_R = 1 \text{ mA}$				4	ns
$I_F = 10 \text{ mA}, U_R = 6 \text{ V},$ $i_R = 0,1 \cdot I_R, R_L = 100 \text{ } \Omega$				2	ns



1N4151